# 热处理温度对表面涂覆 TiO<sub>2</sub> 薄膜的 金刚石成键及抗氧化性能的影响

## 刘小磐<sup>1,2</sup>,宋冬冬<sup>1</sup>,万 隆<sup>1</sup>,庞先兵<sup>1</sup>,李 争<sup>1</sup>

(1. 湖南大学,湖南 长沙 410082)(2. 广东风华高科技材料股份有限公司,广东 肇庆 526000)

摘 要:利用溶胶-凝胶法在金刚石表面涂覆一层 TiO<sub>2</sub>薄膜,通过扫描电镜、红外光谱、拉曼光谱、X 射线衍射、光电子能谱、综合热分析、破裂强度试验等测试方法,表征了热处理温度对金刚石表面 TiO<sub>2</sub> 薄膜的形貌、相组成、相变、与基体金刚石的成键和涂膜后金刚石抗氧化性能的影响。结果表明:热处理温度上升到 600℃时,金刚石表面的 TiO<sub>2</sub>薄膜会由 无定型态转变为致密的锐钛矿相薄膜,TiO<sub>2</sub>与金刚石基体形成 Ti-O-C 化学键合;热处理温度为 800℃时,TiO<sub>2</sub>薄膜依然为锐钛矿相,金刚石基体产生石墨化,石墨 C 也能与 TiO<sub>2</sub>薄膜形成 Ti-O-C 化学键合,但薄膜开始出现裂纹。同时,TiO<sub>2</sub> 薄膜的热处理温度对金刚石在空气中的抗氧化性能有较大影响,当热处理温度在 600 ℃时,金刚石的起始氧化温度达到最大值 754 ℃,在空气中 800 ℃氧化 0.5 h 金刚石的氧化失重率达到最小值 6.7%,抗压强度达到最大值 15.7 N。

关键词: 金刚石; TiO<sub>2</sub>; 薄膜; 热处理; 抗氧化性

中图法分类号: TG731; TG74<sup>+</sup>3

文献标识码:A

文章编号: 1002-185X(2017)01-0195-06

金刚石为目前已知最硬的物质,是制造耐磨工具的 理想材料。大多数金刚石工具的制备方法都是将粉末状 的金刚石与结合剂混合均匀后,通过压制和烧结,制备 成具有一定形状和强度的金刚石工件。但是金刚石的热 稳定性差,在制备工具的烧结过程中会被空气气氛氧化, 在保护气氛中易发生石墨化转变[1.2]。同时金刚石与大多 数结合剂润湿性差,所以工程上经常对金刚石砂轮所用 金刚石进行表面改性。目前常用的表面改性方法为电镀 法,通过对电镀液加上直流电压,使金属单质沉积于阴 极附近的金刚石磨料表面。通过该方法可以在金刚石表 面镀覆 Cr、Ni、Cu、Al 等金属。但是大量研究表明, 在制备陶瓷结合剂金刚石磨具过程中,金属镀层在烧结 过程中容易被氧化而脱落,另外金属镀层与陶瓷结合剂 的润湿性也较差,对该类工具的使用寿命提高有限<sup>[3,4]</sup>。 本研究采用溶胶-凝胶工艺在金刚石表面涂覆致密的 TiO<sub>2</sub>薄膜,探讨了热处理温度对金刚石表面 TiO<sub>2</sub>薄膜 的化学键形成和涂膜后金刚石抗氧化性的影响,为开发 实用性的金刚石材料表面改性技术提供了一条新思路。

## 1 实 验

实验用原料规格如表1所示。

表 1 实验原材料规格 Table 1 Chemical formula and purity of the raw materials

Name	Chemical formula	Purity	
Diamond (45#/50#)	С	Industrial grade	
Butyl titanate	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	C P	
Diethanol amine	$HN(OC_2H_5)_2$	A R	
Absolute ethyl alcohol	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH	A R	
Hydrochloric acid	HCl	A R	
Acetone	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	A R	

实验以钛酸丁酯(Ti(OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>)、无水乙醇、去离 子水和二乙醇胺[HN(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]为原料制备TiO<sub>2</sub>溶胶, TiO<sub>2</sub>溶胶的化学组成(物质的量之比)为Ti(OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>: C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH:H<sub>2</sub>O:HN(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>=1:26.5:1:1。其制备方法如 下:在搅拌下将钛酸丁酯溶于无水乙醇中,接着加入 二乙醇胺,待溶液混合均匀后,再滴加体积比为 H<sub>2</sub>O:C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH=1:10的乙醇水溶液,继续搅拌1h,室 温下陈化24h,获得浅黄色溶胶。

金刚石材料处理过程如下:金刚石颗粒置于小试

收稿日期: 2015-12-13

基金项目:国家自然科学基金(51375157);湖南省科技计划项目(2012FJ6038);中央高校基本科研业务费

作者简介: 刘小磐, 男, 1979 年生, 博士, 讲师, 湖南大学材料科学与工程学院, 湖南 长沙 410082, 电话: 0731-88823540, E-mail: liuxiaopanjj@126.com

剂瓶中, 先用 1 mol/L 的盐酸溶液浸泡 1 h, 用去离子 水冲洗至冲洗液 pH 值为 7。电热烘干后, 浸入丙酮中 超声波清洗 1 h, 再用去离子水冲洗, 烘干备用。实验 涂覆 TiO<sub>2</sub>薄膜时, 首先将上述处理的工业金刚石材料 浸泡于 TiO<sub>2</sub>溶胶中, 静置 1 min 后用铜网捞出, 置于 80 ℃烘箱中干燥 5 min 后再冷却, 重复浸渍涂膜 3 次。 涂膜完成后, 在 N<sub>2</sub> 保护下对金刚石进行后期热处理: 先在马弗炉内升温至 100 ℃保温 30 min, 然后将炉温 以 5 ℃/min 的速度升至不同最终热处理温度, 保温 1 h 后在炉内自然冷却, 制得表面涂覆 TiO<sub>2</sub>薄膜的金刚 石材料。

采用 JSM-6700F 型扫描电镜对金刚石表面薄膜进 行形貌观察;采用 D8-ADVANCE 型 X 射线衍射仪 (Cu Kα 辐射线, λ=0.1541 nm)对金刚石表面薄膜进 行 XRD 分析,工作电压 35 kV,工作电流 30 mA。

通过 KBr 压片法在傅里叶红外光谱仪(SPECTRUM one)上测量涂膜后的金刚石磨料的红外吸收光谱,测 定波数范围 500~4000 cm<sup>-1</sup>。

在 LABRAM-010 型激光共焦 Raman 光谱仪上测 试不同试样的 Raman 谱,通过物质的特征 Raman 振 动确定样品的晶型转变。

采用 PHI Quantum2000 型 X 射线光电子能谱分析 仪对涂膜金刚石样进行 XPS 分析, X 射线源为 Al Kα, 试验真空度 10<sup>-6</sup> Pa,工作电压 20 kV。

称取一定质量的涂膜金刚石样品,置于 NETZSCH--DIL402PC综合热分析仪中进行热重分 析,升温速率为10℃/min,气氛为空气,坩埚材质 为 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,测试温度范围为室温~800 ℃,以试样失 重曲线下降段最大斜率与基线交点温度为磨料开始氧 化温度。

用陶瓷坩埚装取一定质量的样品,置于马弗炉内, 升温至 800 ℃进行氧化试验。每隔一定时间取出坩 埚,测量残余样品的质量,计算出样品在不同氧化时 间下的氧化失重率。

采用 JLK 型破裂强度试验机,测量 45/50#单颗金 刚石氧化试验后的抗压强度,其强度取 10 颗样品的平均值。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 热处理温度对薄膜显微结构及相组成的影响

不同温度热处理后,金刚石表面 TiO<sub>2</sub>薄膜的形貌 如图 1 所示。未进行热处理时,金刚石表面为 TiO<sub>2</sub>凝 胶膜,薄膜光滑平整,未见有颗粒析出(图 1a)。200 ℃ 保温后(图 1b),薄膜发生脱水、脱醇反应,但表面依然 平整光滑。400 ℃热处理后(图 1c),薄膜中开始析出细 小的颗粒,薄膜虽然连续,但存在大量的气孔。这主要 是在该温度有大量的结晶水从薄膜中脱除,水蒸气从薄 膜挥发后留下的气孔<sup>[5]</sup>。600 ℃热处理后(图 1d),薄膜 由 100~300 nm 的 TiO<sub>2</sub>颗粒组成,颗粒之间排列紧密, 薄膜致密度高。700 ℃热处理后(图 1e),薄膜中的 TiO<sub>2</sub> 颗粒出现二次晶粒长大,原来细小的 TiO<sub>2</sub>颗粒之间的 界面开始出现烧结的迹象,薄膜局部出现裂纹。800 ℃ 热处理后(图 1f),薄膜中的 TiO<sub>2</sub>颗粒间的烧结现象更 加明显,晶粒进一步长大,薄膜中的裂纹更加明显。



图 1 不同温度热处理薄膜的形貌(N<sub>2</sub>气保护下保温 1 h)

Fig.1 Film topographys heated at different temperatures: (a) untreated, (b) 200 °C, (c) 400 °C, (d) 600 °C, (e) 700 °C, and (f) 800 °C

图 2 为不同温度热处理后金刚石表面 TiO<sub>2</sub>薄膜的 XRD 图谱。由图可以看出:当热处理温度低于 400 ℃ 时,TiO<sub>2</sub>为无定型结构;当温度升高到 600 ℃时,薄 膜 XRD 图谱中含有少量锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>的衍射峰。随 着热处理温度的升高,衍射峰强度慢慢增强,结晶化 程度逐渐提高;热处理温度升高到 800 ℃,锐钛矿的 峰变得较尖锐,但没有出现晶相转变<sup>[6-8]</sup>。

图 3 为不同温度热处理后金刚石表面 TiO<sub>2</sub> 薄膜的 拉曼图谱。当热处理温度低于 400 ℃时,并没有观察 到任何拉曼吸收峰,表明此时薄膜为无定形态;600 ℃ 热处理后,薄膜在 398、515 和 640 cm<sup>-1</sup>处出现对称 性较差的拉曼峰。以上 3 个波数对应的均为锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的拉曼峰,说明此时薄膜开始析出锐钛矿相,但 结晶度较差;随着热处理温度的升高,薄膜在 398、515 和 640 cm<sup>-1</sup>处出现对称性高,且强度逐渐增强的拉曼 峰。但是未在其他位置出现拉曼峰,说明随着热处理温 度的升高,薄膜中锐钛矿相增多,结晶度提高<sup>[9]</sup>。

#### 2.2 热处理温度对 TiO<sub>2</sub>薄膜化学键形成的影响

图4为涂覆TiO2薄膜的金刚石经不同温度热处理



图 2 不同温度热处理后金刚石表面 TiO2 薄膜的 XRD 图谱

Fig.2 XRD patterns of TiO<sub>2</sub> films heated at different temperatures









图 4 不同热处理温度下 TiO2 薄膜的红外光谱

Fig.4 IR spectra of TiO<sub>2</sub> films heated at different temperatures (-a 200 °C, -b 400 °C, -c 600 °C, -d 800 °C)

后的红外光谱。a, b, c, d 谱线中 3080~3415 cm<sup>-1</sup>处 的吸收峰是-OH 基团伸缩振动引起的,是由吸附水产 生:1639 cm<sup>-1</sup> 处为 H-O-H 的弯曲振动,与结构水有关; 1450 cm<sup>-1</sup>处的吸收峰为 CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>中 C-O 振动,由涂膜溶 胶的有机前驱体引入<sup>[10]</sup>。a 谱线中 2862~2922 cm<sup>-1</sup>处 的吸收峰是由亚甲基-CH2-的弯曲振动所产生的, b, c, d 谱线中未出现此峰,样品经 400 ℃以上热处理后该 有机基团被排除。a 谱线中 1075 cm<sup>-1</sup> 处的吸收峰代表 Ti-O-C 化学键的特征振动,该基团是 TiO,与其表面有 机团中游离的 C 在 200 ℃时反应形成。当热处理温度 上升到 400 ℃时,绝大部分游离 C 在热处理条件下不 再形成 Ti-O-C 键, 该特征峰消失 (如 b 谱线)。600℃ 热处理后, c 谱线在 1086 cm<sup>-1</sup> 处出现较强吸收峰。根 据文献[10]报道,此为 Ti-O-C 基团的特征振动。 Ti-O-C 基团中的 C 为基底金刚石中的 C, 其峰值比 a 谱线中的峰值后移 10 cm<sup>-1</sup>,可解释为金刚石中的 C, 其化学环境与a谱线中TiO,表面有机团中游离的C不 同,造成 Ti-O-C 化学键的特征振动频率改变。800 ℃ 热处理后,d谱线在1071 cm<sup>-1</sup>处出现较强吸收峰,对 应的也为 Ti-O-C 基团的特征振动峰, 但是比 c 谱线前 移了大约 5 cm<sup>-1</sup>。

图 5 为不同温度热处理后镀膜金刚石的拉曼光 谱。图5显示,经过600 ℃热处理的涂膜金刚石在1325 cm<sup>-1</sup>处出现尖锐峰(图 5a),该特征震动峰对应于金 刚石晶体。当涂膜后的金刚石在800℃进行热处理后, 拉曼光谱在1372和1597 cm<sup>-1</sup>处出现了宽化的特征峰 (图 5b),该宽化峰是由石墨、类金刚石碳和金刚石 碳共同形成的<sup>[11]</sup>。拉曼光谱表明,涂膜后的金刚石在 800 ℃热处理时,部分金刚石发生了相变,转变为石 墨相,部分石墨 C 与薄膜中的 Ti 元素形成 Ti-O-C 化 学键,引起了红外吸收峰位移<sup>[12]</sup>。



图 5 不同热处理温度下涂膜金刚石的拉曼光谱 Fig.5 Raman spectra of diamond coated TiO<sub>2</sub> films heated at different temperature: (a) 600 ℃ and (b) 800 ℃

图 6 为不同温度热处理后 TiO<sub>2</sub>薄膜中 Ti 元素的 XPS 图谱。数据表明,当薄膜在 400 ℃进行热处理后 薄膜中主要存在 Ti<sup>4+</sup>和 Ti<sup>3+</sup>,只有少量的 Ti<sup>2+</sup>。当薄膜 在 600 ℃以上进行热处理后薄膜中主要存在 Ti<sup>4+</sup>和 Ti<sup>2+</sup>,只有少量的 Ti<sup>3+</sup>。这主要是因为薄膜在 600 ℃ 以上进行热处理后,薄膜中游离 C 被大部分去除,TiO<sub>2</sub> 薄膜开始与金刚石基体产生 Ti-O-C 键合,所以薄膜中 Ti<sup>3+</sup>含量减少,Ti<sup>2+</sup>含量增加<sup>[13]</sup>。

## 2.3 TiO<sub>2</sub> 薄膜热处理温度对金刚石抗氧化性能和力 学性能的影响

表2为不同温度热处理后镀TiO<sub>2</sub>薄膜的金刚石的 抗氧化性能。数据表明,金刚石表面的TiO<sub>2</sub>薄膜的热





处理温度对金刚石的抗氧化性能有较大影响。结合图 1,当 TiO<sub>2</sub>薄膜热处理温度在 400 ℃以下时,金刚石 表面的薄膜为无定形态,由于有机物和水的挥发,薄 膜中存在大量气孔,致密度差,涂膜后金刚石的起始 氧化温度有小幅度上升;当热处理温度在 600 ℃时, 金刚石表面的薄膜为锐钛矿型 TiO<sub>2</sub>,晶粒细小结构紧 密,此时金刚石的起始氧化温度达到最大值 754 ℃ (图 7),随着热处理温度的进一步升高,基体金刚石 开始向石墨相转变,薄膜与金刚石基体的结合力下降, 薄膜出现裂纹。在 800 ℃处理后,金刚石的起始氧化 温度下降到 727 ℃。实验所用的 45#/50#金刚石未热 处理的单颗抗压强度为 24.6 N,800 ℃氧化 0.5 h 后未 涂膜金刚石的抗压强度为 0,而 600 ℃热处理后金刚 石的强度还能达到 15.7 N。

图 8 为不同温度热处理后涂 TiO<sub>2</sub>薄膜的金刚石在空 气中 800 ℃下保温的失重率曲线。在氧化实验的前 0.5 h,当热处理温度低于 600 ℃时,随着热处理温度的升 高,样品氧化失重率下降;当热处理温度为 600 ℃时, 样品的氧化失重率达到最低值 6.7%;继续升高热处理温 度,样品的氧化失重率随着热处理温度的升高而上升。

表 2 不同温度热处理后镀 TiO₂薄膜的金刚石的抗氧化性能 Table 2 Anti-oxidation of diamond coated TiO₂ films beated at different temperatures

Tuble = This origination of autoball for the found of the					
Heat treatment temperature/°C	Initial oxidation temperature/°C	Mass loss rate of diamond oxidized at 800 °C for 0.5 h in air/%	Mass loss rate of diamond oxidized at 800 °C for 2 h in air/%	Compressive strength of diamond oxidized at 800 °C for 0.5 h in air/N	
Untreated	687	24.3	74.7	0	
200	692	21.4	72.8	2.4	
400	702	16.7	68.4	5.3	
600	754	6.7	60.2	15.7	
700	748	8.9	63.9	12.3	
800	727	10.1	65.2	10.7	



图 7 不同温度热处理后镀 TiO<sub>2</sub> 薄膜金刚石的 DSC-TG 曲线 Fig.7 DSC-TG curves of diamond coated TiO<sub>2</sub> films heated at different temperatures: (a) 400 ℃, (b) 600 ℃, and

(c) 800 °C



图 8 不同温度热处理后涂膜金刚石在空气中 800 ℃下 氧化失重率曲线



图 9 为不同温度热处理后镀膜金刚石在空气中 800 ℃保温 0.5 h 的表面形貌。未镀膜金刚石(图 9a) 的氧化腐蚀相当严重, 磨料中出现了很深的氧化腐蚀 裂纹,有些碎裂成了小块;400 ℃热处理后(图 9b), 金刚石氧化现象有所改善,金刚石表面的 TiO2 薄膜完 全脱落, 金刚石尖角被完全氧化, 本来光滑的磨料表 面由于氧化出现起伏的台阶和圆形的氧化孔,这些孔 洞的出现主要是由于金刚石中存在大量的螺旋位错缺 陷,而这些缺陷会优先与氧气反应,在位错附近产生 孔洞<sup>[14]</sup>: 600 ℃热处理样品(图 9c),表面依然存在 连续的 TiO<sub>2</sub>薄膜,但是薄膜已开始龟裂,部分出现了 薄膜剥落的趋势; 800 ℃热处理样品(图 9d),表面 开始被氧化得高低不平,但棱角还存在,同时表面存 在许多球形颗粒,能谱表明该球形颗粒为 TiO<sub>2</sub>。由此 可推断,随着氧化时间的进一步延长,金刚石表面的 TiO<sub>2</sub>薄膜会完全脱落,失去了对金刚石基体的保护, 因此当氧化时间超过 0.5 h 后,所有的金刚石样品均表 现为加速氧化(图8)。



- 图 9 不同温度热处理后镀膜金刚石在空气中 800 ℃保温 0.5 h 的表面形貌
- Fig.9 Surface morphologies of diamond coated TiO<sub>2</sub> films heated at different temperatures after oxidation at 800 °C for 0.5 h in air: (a) uncoated, (b) 400 °C, (c) 600 °C, and (d) 800 °C

# 3 结 论

 1) 当热处理温度低于 600 ℃时,金刚石表面 TiO<sub>2</sub> 薄膜为无定型,薄膜中存在大量气孔;热处理温度为
 600 ℃时,薄膜转变为致密的锐钛矿相薄膜;热处理 温度为 800 ℃时, TiO<sub>2</sub> 薄膜依然为锐钛矿相, 薄膜 开始出现裂纹。

2)涂膜后金刚石经过 400 ℃热处理,TiO<sub>2</sub>薄膜 与金刚石基体未形成化学键; 600 ℃热处理后,TiO<sub>2</sub> 薄膜能与金刚石基体形成 Ti-O-C 化学键合。当经 800 ℃热处理时,金刚石基体产生石墨化,石墨 C 也 能与 TiO<sub>2</sub>薄膜形成 Ti-O-C 化学键合。

3) 当热处理温度在 600 ℃时,金刚石的起始氧 化温度达到最大值 754 ℃,在空气中 800 ℃氧化 0.5 h 金刚石的氧化失重率达到最小值 6.7%,抗压强度达到 最大值 15.7 N。

#### 参考文献 References

- Mamails A G, Horvath M, Grabchenko A I. Journal of Materials Processing Technology[J], 2000, 97(11): 120
- [2] Duan Duanzhi(段端志). Dissertation for Master(硕士论文)
  [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2012
- [3] Zhong D, Moore J J. Electronics Letters[J], 2003, 63(30): 50
- [4] Dong Hongfeng(董洪峰), Lu Yang(路 阳), Li Wensheng(李文 生) et al. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy(粉末冶金材料科学与工程)[J], 2013(1): 125
- [5] Yu Kaifeng, Zhao Jingzhe, Tian Yumei et al. Materials Letters

[J], 2005, 59: 3563

- [6] Wang Ruifen(王瑞芬), Wang Fuming(王福明), An Shengli(安 胜利) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属 材料与工程)[J], 2014, 43(9): 2293
- [7] Shang Peng, Xiong Shengming, Li Linghui et al. Applied Surface Science[J], 2013, 28: 713
- [8] Yu Chunhang(于春杭), Shao Honghong(邵红红), Xu Xiaojing (许晓静). Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材 料与工程)[J], 2012, 41(2): 321
- [9] Zeng Guang, Li KaiKai, Yang Huagui et al. Vibrational Spectroscopy[J], 2013, 68: 279
- [10] Hu Weida, Wan Long, Liu Xiaopan et al. Applied Surface Science[J], 2011, 257(4): 5777
- [11] Hu Weida, Wan Long, Liu Xiaopan et al. Journal of Ceramic Processing Research[J], 2012, 13(2): 83
- [12] Liu Xiaopan, Qiao Ang, Wan Long. Journal of Wuhan University Technology[J], 2014, 43(1): 19
- [13] Wahab A K, Bashir S, Al-Salik Y et al. Applied Petrochemical Research[J], 2014, 4: 55
- [14] Lin Kuan-Hong, Peng Shih-Feng, Lin Shun-Tiab. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2007, 25(1): 25

## Influence of Heat Treatment Temperature on Bonding and Oxidation Resistance of Diamond Coated TiO<sub>2</sub> Film

Liu Xiaopan<sup>1,2</sup>, Song Dongdong<sup>1</sup>, Wan Long<sup>1</sup>, Pang Xianbing<sup>1</sup>, Li Zheng<sup>1</sup> (1. Hunan University, Changsha 410082, China)

(2. Guangdong FengHua Advanced Technology (Holding) Co., LTD., Zhaoqing 526000, China)

**Abstract:** TiO<sub>2</sub> films were prepared on the surface of diamond through a sol-gel method. The effect of heat treatment temperature on morphology, phase composition, phase transition, bonding with diamond, and oxidation resistance of diamond coated with TiO<sub>2</sub> films were characterized through SEM, FTIR, Raman spectroscopy, X-ray diffraction analysis, XPS, TG-DSC and fracturing strength tests. The results show that when the heat treatment temperature rises to 600 °C, TiO<sub>2</sub> film on the diamond surface changes from amorphous state to a dense anatase film and Ti-O-C chemical bond is formed between TiO<sub>2</sub> and diamond substrate. When the heat treatment temperature increases to 800 °C, TiO<sub>2</sub> film is still anatase phase, graphitization of diamond substrate occurs, graphitized C forms Ti-O-C chemical bond with TiO<sub>2</sub> film; however, TiO<sub>2</sub> film begins to crack. Meanwhile, the heat treatment temperature of TiO<sub>2</sub> films has a greater impact on the oxidation resistance of diamond in air. When the heat treatment temperature is 600 °C, the initial oxidation temperature of the diamond reaches a maximum value of 754 °C. After oxidation at 800 °C for 0.5 h in air, the mass loss rate and compressive strength is 6.7 wt% and 15.7 N, respectively.

Key words: diamond; TiO<sub>2</sub>; film; heat treatment; oxidation resistance

Corresponding author: Liu Xiaopan, Ph. D., Lecturer, College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082, P. R. China, Tel: 0086-731-88823540, E-mail: liuxiaopanjj@126.com